

2SD478

シリコン NPN 三重拡散形

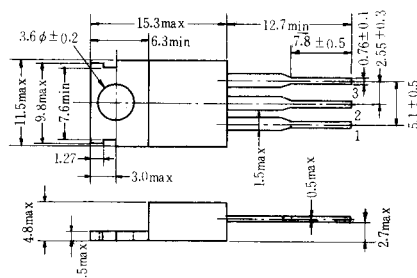
TV垂直偏向出力用

2SB568とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

TV VERTICAL DEFLECTION OUTPUT

Complementary pair with 2SB568



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

アクセサリ Accessories

スペーサ	Spacer	SK16B
ワッシャ	Washer	YC20A YZ033S

■最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD478	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CB0}	200	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CE0}	150	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EB0}	6	V
コレクタ電流		I_C	2	A
せん頭コレクタ電流		$i_{C(\text{peak})}$	5	A
許容コレクタ損失		P_C	1.8	W
		P_{C^*}	30	W
接合部温度		T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45~+150	$^{\circ}\text{C}$
リード温度(耐ハンダ熱)		$T\varnothing^{**}$	260	$^{\circ}\text{C}$

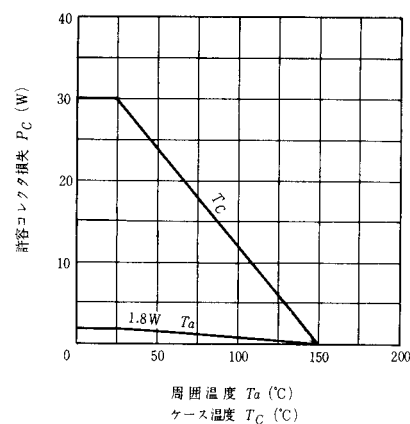
* $T_C=25^{\circ}\text{C}$ における許容値

** レジン本体から1.5mm以上離れたリード端子部分において10sec以内における許容値

* Value at $T_C=25^{\circ}\text{C}$

** Value at distance 1.5mm from case for 10sec max.

許容コレクタ損失の周囲温度、ケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	150	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EB0}$	$I_E=5\text{mA}$, $I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=120\text{V}$, $I_E=0$	—	—	1	μA
直流電流増幅率		h_{FE1}^*	$V_{CE}=4\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	60	—	320	
		h_{FE2}	$V_{CE}=4\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$	60	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	—	—	1.0	V
2次破壊電流		I_M	$V_{CE}=120\text{V}$ 50Hz Half Wave, 30Pulses	0.6	—	—	A
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB}=100\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$	—	22	—	pF

*2SD478は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

*The 2SD478 is grouped by h_{FE1} as follows.

Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
60~120	100~200	160~320